В начало Курсы ФИиВТ 09.03.04 Программная инженерия(Очная) ПС 11 Разработка программных систем 4 семестр

(09.03.04 11 4 сем о)Физика Дополнительные виды работ Полупроводниковый диод (защита)

Тест начат Пятница, 14 Июнь 2024, 16:45

Состояние Завершенные

Лятница, 14 Июнь 2024, 16:59

Прошло 14 мин. 3 сек.

времени

Баллы 5,00/6,00

Оценка 3,33 из 4,00 (83%)

Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Приведите в соответствие выражения, приведенные ниже:

Если валентная зона при T=0°K **полностью заполнена** электронами, а ширина запрещенной зоны **более 2 эВ**, то это ...

диэлектрик

полупроводник

Если валентная зона при T=0°К **полностью заполнена** электронами, а ширина запрещенной зоны **менее 2 эВ**, то это ...

Ваш ответ верный.

Вопрос 2			
Верно Баллов: 1,00 из 1,00			
На рисунке представлена схема энергетических зон полупроводника <i>n</i> – типа.			
A Б			
$footnote{f B}$			
Буква А обозначает			
Выберите один ответ:			
валентную зону			
уровень Ферми при T = 0 K			
О донорный уровень			
⊚ зону проводимости ✔			
○ уровень Ферми при T больше 0 K			
Ваш ответ верный.			
Вопрос 3			
Верно			
Баллов: 1,00 из 1,00			
Укажите верные утверждения для полупроводника р-типа :			
Выберите один или несколько ответов:			
✓ Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✓			
Уровень Ферми при Т = 0° К находится между акцепторным уровнем и потолком валентной зоны ✓			
□ Энергия активации заряда равна половине энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны			
Ваш ответ верный.			

Вопрос 4			
Верно			
Баллов: 1,00 из 1,00			
При контакте двух полупроводников различного типа проводимости			
Выберите один или несколько ответов:			
 ✓ в приграничном слое возникает объемный заряд примесных ионов, препятствующий диффузии <u>основных</u> носителей заряда ✓ 			
■ в приграничном слое возникает объемный заряд примесных ионов, препятствующий диффузии неосновных носителей заряда			
начинается диффузия <u>неосновных</u> носителей из одного полупроводника в другой полупроводник			
✓ начинается диффузия <u>основных</u> носителей из одного полупроводника в другой полупроводник			
Ваш ответ верный.			
_ F			
Вопрос 5 Неверно			
Баллов: 0,00 из 1,00			
Укажите верные ответы для контакта двух полупроводников разного типа проводимости при подключении его к внешнему источнику напряжения:			
При <u>обратном</u> включении контакта ток <u>неосновных</u> носителей при увеличении напряжения линейно растет из-за…		уменьшения поля контакта	
При <u>прямом</u> включении контакта ток <u>основных</u> носителей при увеличении			
напряжения растет по экспоненте из-за		увеличения объема области контакта	
		×	
Ваш ответ неправильный.			
Вопрос 6			
Верно			
Баллов: 1,00 из 1,00			
Укажите <u>изменения в вольт-амперной характеристике</u> полупроводникового диода, если его нагреть до +40° C.			
сопротивление диода при обратном включении	уменьшится ✓		
сопротивление диода при прямом включении	уменьшится ✓		
	,		
Ваш ответ верный.			